

2SC4326LK

エピタキシャルプレーナ形NPNシリコントランジスタ
Epitaxial Planar NPN Silicon Transistor
RF スイッチ用/RF Switch Usage

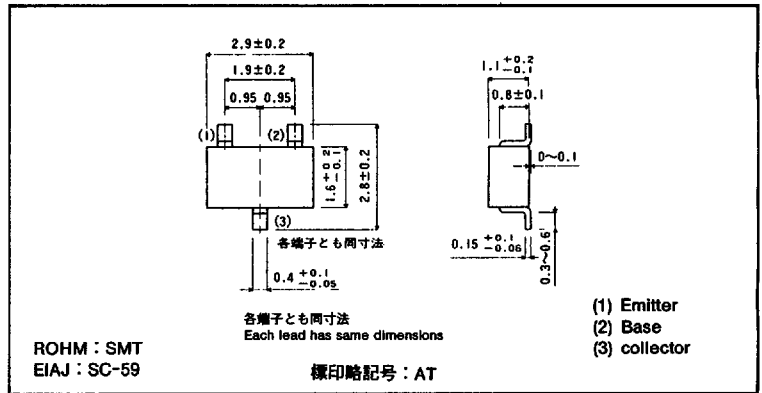
● 特長

- 出力オン抵抗 Ron が小さい。
- 容量が小さい。
- RF モジュレータ等の RF スイッチ用として最適。

● Features

- Low output ON resistance
- Low capacitance
- Suitable for RF modulator & RF switch usage.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V _{CBO}	12	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	6	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EBO}	3	V
コレクタ電流	I _C	50	mA
コレクタ損失	P _C	150	mW
接合部温度	T _j	150	°C
保存温度範囲	T _{stg}	-55~150	°C

● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・ベース降伏電圧	BV _{CBO}	12	—	—	V	I _C = 10 μA
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV _{CEO}	6	—	—	V	I _C = 1mA
エミッタ・ベース降伏電圧	BV _{EBO}	3	—	—	V	I _E = 10 μA
コレクタシャ断電流	I _{CBO}	—	—	0.5	μA	V _{CB} = 10V
エミッタシャ断電流	I _{EBO}	—	—	0.5	μA	V _{EB} = 2V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	—	—	0.3	V	I _C /I _B = 10mA/1mA
直流電流増幅率	h _{FE}	120	—	560	—	V _{CE} /I _C = 5V/5mA
利得帯域幅積	f _T	300	800	—	MHz	V _{CE} = 5V, I _C = 10mA, f = 200MHz
出力容量	C _{ob}	—	1.1	1.8	pF	V _{CB} = 10V, I _E = 0, f = 1MHz
出力オン抵抗	R _{on}	—	2.8	—	Ω	I _B = 3mA, v _i = 100mVrms, f = 500kHz

h_{FE} の値により下表のように分類します。

Item	Q	R	S
h _{FE}	120~270	180~390	270~560

● 標準品・標準準品一覧表 (○:標準準品 △:特別仕様)

Type	h _{FE}	包装名	テーピング	
		記号	T146	T147
		基本発注単位(個)	3000	3000
2SC4326LK	QRS		○	△

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves

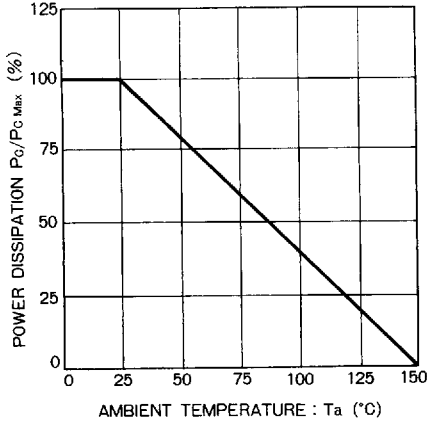


Fig.1 電力軽減曲線

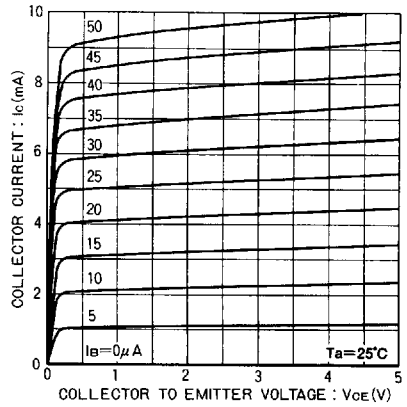


Fig.2 エミッタ接地出力静特性

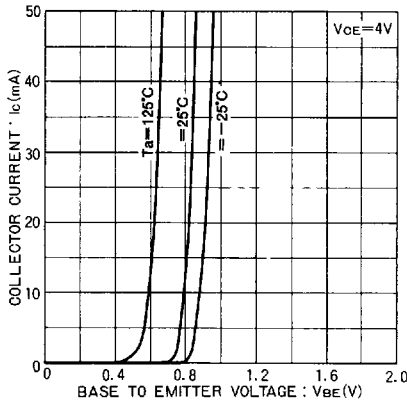


Fig.3 エミッタ接地伝達静特性

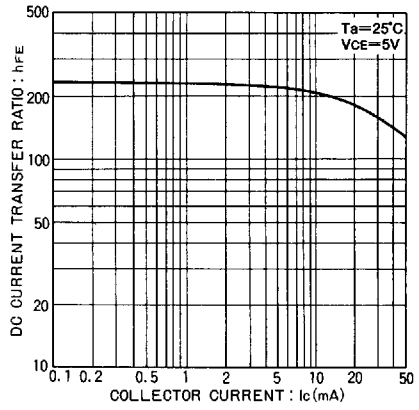


Fig.4 直流電流増幅率—コレクタ電流特性

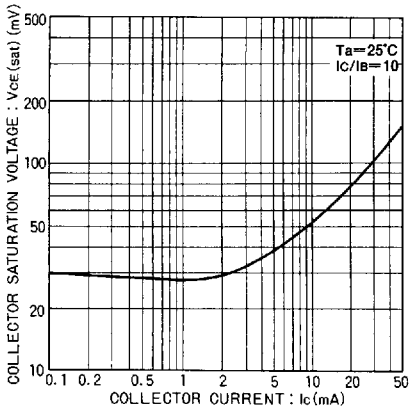


Fig.5 コレクタ・エミッタ間飽和電圧
—コレクタ電流特性

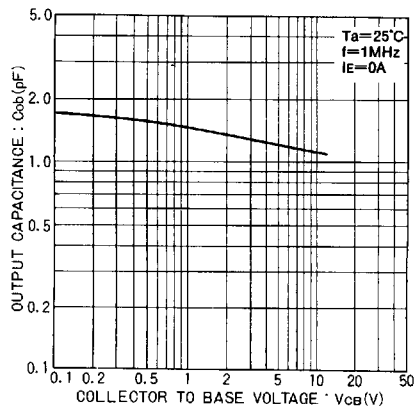


Fig.6 コレクタ出力容量—電圧特性

トランジスタ

2SC4326LK

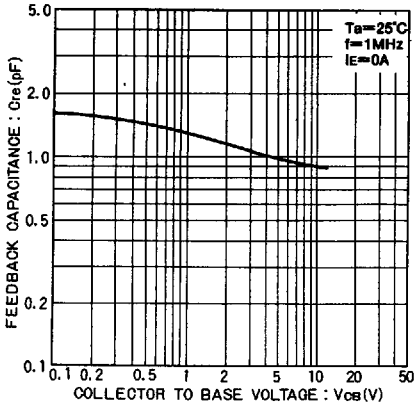


Fig.7 帰還容量—電圧特性

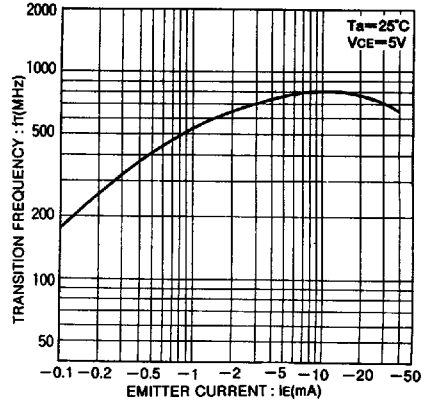


Fig.8 利得帯域幅積—エミッタ電流特性

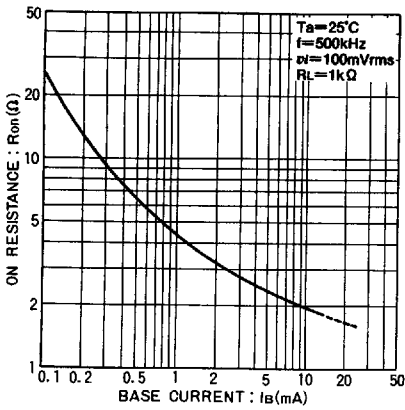


Fig.9 出力オン抵抗—ベース電流特性

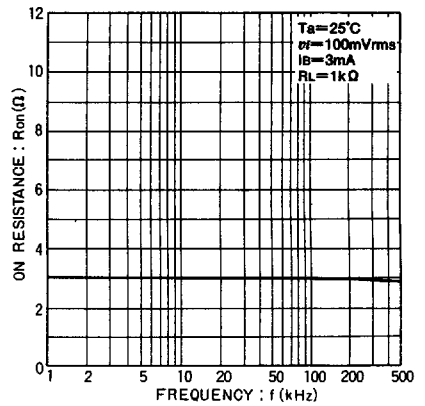


Fig.10 出力オン抵抗—周波数特性

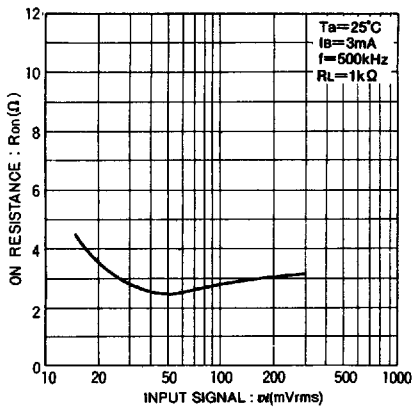


Fig.11 出力オン抵抗—入力信号特性

● Ron測定回路図

